

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ

13-е заседание Председатель – Шамирзаев Т.С.

9³⁰ – 9⁴⁵

А.В.Царев^{1,2}, *Р.М.Тазиев*¹.

Особенности моделирования интегрально-оптических элементов для радиофотоники.

¹ *Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*

² *Новосибирский государственный университет, Новосибирск.*

9⁴⁵ – 10¹⁵

О.Е.Терещенко^{1,2}, *С.В.Иванов*³, *Н.А.Половников*¹, *А.А.Соколов*³, *В.С.Русецкий*^{1,4}, *В.А.Голяшов*^{1,2}, *А.С.Ярошевич*¹, *А.В.Миронов*⁴, *А.Ю.Дёмин*⁴.

Новая концепция пировидикона на основе пироэлектрического электронно–оптического преобразователя диапазона 1-12 мкм

(приглашенный доклад).

¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*

² *Новосибирский государственный университет, Новосибирск;*

³ *Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск;*

⁴ *ЗАО «ЭКРАН-ФЭП», Новосибирск.*

10¹⁵ – 10³⁰

М.А.Суханов, *А.К.Бакаров*, *И.Д.Лошкарёв*, *К.С.Журавлев*.

InSb/InAlSb гетероструктуры для ИК фотоприемников с повышенной рабочей температурой.

Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск.

10³⁰ – 10⁴⁵

О.Э.Камешков^{1,2}, *В.В.Герасимов*^{1,2}, *Б.А.Князев*^{1,2}.

Численное моделирование сенсоров на основе линейных металлических решеток.

¹ *Новосибирский государственный университет, Новосибирск;*

² *Институт ядерной физики им. Будкера СО РАН, Новосибирск.*

10⁴⁵ – 11⁰⁰ **Д.В.Гуляев**, Д.В.Дмитриев, Е.А.Колосовский,
А.В.Царев, К.С.Журавлев.
Гетероструктуры InGaAlAs/InAlAs на фосфид
индиевой подложке для электрооптического
модулятора Маха-Цендера.
Институт физики полупроводников им. А. В.
Ржанова СО РАН, Новосибирск.

11⁰⁰ – 11³⁰ Кофе-брейк

14-е заседание Председатель – Федоринин В.Н.

11³⁰ – 11⁴⁵ А.В.Голицын¹, А.А.Голицын^{1,2}, А.О.Лебедев¹,
Б.Н.Новгородов, А.Р.Новоселов¹, **А.Г.Паулиш**^{1,2,3},
С.М.Чурилов¹, П.И.Шапор¹, К.П.Шатунов¹.
Направления развития оптико-электронных систем и
приборов в Филиале ИФП СО РАН "КТИПМ".

¹ Новосибирский филиал ИФП СО РАН "КТИПМ",
Новосибирск;

² Новосибирский государственный технический
университет, Новосибирск;

³ Новосибирский государственный университет,
Новосибирск.

11⁴⁵ – 12⁰⁰ **Б.Г.Вайнер**^{1,2}.

Матричное тепловидение нового поколения в химии и
химической физике.

¹ Институт физики полупроводников им. А.В.
Ржанова СО РАН, Новосибирск;

² Новосибирский государственный университет,
Новосибирск.

12⁰⁰ – 12¹⁵ **Р.А.Гладков**, И.И.Кремис.

Микросканер для тепловизора третьего поколения.
Новосибирский филиал ИФП СО РАН "КТИПМ",
Новосибирск.

12¹⁵ – 12³⁰

В.А.Швец^{1,2}, *Д.В.Марин*¹, *И.А.Азаров*¹, *М.В.Якушев*¹,
*С.В.Рыхлицкий*¹.

Эллипсометрическая in situ диагностика температуры в технологии выращивания слоёв кадмий-ртуть-теллур методом молекулярно-лучевой эпитаксии.

¹ *Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН, Новосибирск;*

² *Новосибирский государственный университет, Новосибирск.*

12³⁰ – 13⁰⁰

Заккрытие конференции

